
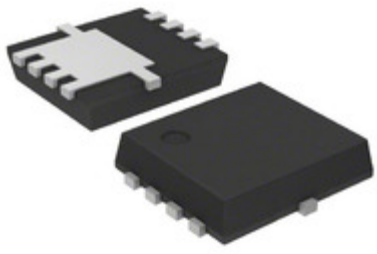

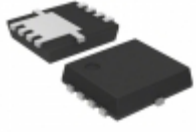




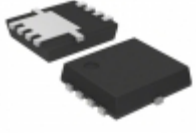

	<h2>RQ3E180AJTB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RQ3E180AJTB</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 18A HSMR8</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RQ3E180AJTB.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RQ3E180AJTB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 18A HSMR8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 11mA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 18A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 30W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4290pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta), 30A (Tc)

RQ3E180AJTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RQ3E180AJTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RQ3E180AJTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RQ3E180AJTB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RQ3E180BN QQ2850920316 RQ3E180BN QQ2850920316</p>	 <p>RQ3E160ADTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 16A 8HSMT</p>	 <p>RQ3E160ADTB1 ROHM/ RQ3E160ADTB1 ROHM/</p>	 <p>RQ3E150MNTB1 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A HSMT8</p>
 <p>RQ3E180GN QQ2850920316 RQ3E180GN QQ2850920316</p>	 <p>RQ3E160AD QQ2850920316 RQ3E160AD QQ2850920316</p>	 <p>RQ3E180BNTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8HSMT</p>	 <p>RQ3G100GN ROHM RQ3G100GN ROHM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RQ3E180AJTB LAPIS Semiconductor	RQ3E180AJTB Datenblatt	RQ3E180AJTB-Datenblätter	RQ3E180AJTB PDF	LAPIS Semiconductor RQ3E180AJTB
RQ3E180AJTB Electronic	RQ3E180AJTB-Komponenten	RQ3E180AJTB-Verteiler	RQ3E180AJTB-Bild	RQ3E180AJTB-Teil
RQ3E180AJTB Preis	RQ3E180AJTB Hersteller	RQ3E180AJTB Bild	RQ3E180AJTB Aktie	RQ3E180AJTB Inventar
RQ3E180AJTB Neu	RQ3E180AJTB Original	RQ3E180AJTB garantiert	RQ3E180AJTB RFQ	RQ3E180AJTB Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited